

Кремниевый фотодетекторный чип 28×28 мил — техническое описание

P/N : WS59-10C

Применение

Спецификация относится к NIP-фотодетекторам.

Структура:

Планарная структура NIP; электроды: верхняя сторона (катод) — алюминий, задняя сторона (анод) — сплав Au

Размер:

Размер чипа	28 мил × 28 мил (±1.5 мил)
Толщина	12 мил ±0.4 мил
Активная область	22 мил × 22 мил (±1.0 мил)
Размер электрода	6 мил × 6 мил
Топология	см. рис. 1

Электрооптические характеристики:

Параметр	Обозначение	Условия	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	VF	IF=10mA, H=0	0.5		1.2	В
Напряжение обратного смещения	VBR	IR=100μA, H=0	35			В
Обратный темновой ток	ID	VR=10V, H=0			10	нА
Емкость	CJ	VR=3V, F=1 MHz		9		пФ
Пиковая длина волны	λp		400	940	1100	нм

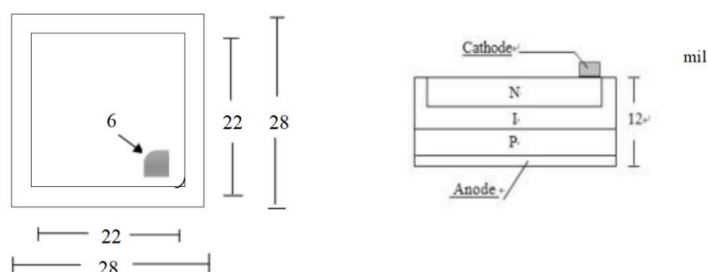


Fig.1